## SEMICONDUCTOR PRESSURE SENSOR

Patent Number:

JP4089541

Publication date:

1992-03-23

Inventor(s):

KATO KAZUYUKI

Applicant(s)::

FUJI ELECTRIC CO LTD

Requested Patent:

□ JP4089541

Application Number: JP19900205669 19900802

Priority Number(s):

IPC Classification: G01L9/04

EC Classification:

Equivalents:

### **Abstract**

PURPOSE: To achieve a higher accuracy of a sensor output by building up a signal processing circuit with a circuit element integrated on a semiconductor substrate and a variable resistance arranged outside a container separately to allow final readjustment.

CONSTITUTION: Pressure sensitivity of a sensor is adjusted by trimming a resistance 35 and a resistance value of a variable resistance 72 provided outside a chip through bonding pads 61 and 62 is varied to adjust the pressure sensitivity just as the resistance 35. Hence, a resistance 72 made as a part of a signal processing circuit is made adjustable and separate arrangement from a semiconductor substrate allows final adjustment of a zero potential or the pressure sensitivity with the resistance 72. This enables the compensation for changes in the zero potential or the pressure sensitivity in the housing of the semiconductor substrate or other operations thereby eliminating changes in output characteristic afterwards.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

THIS PACE BLAME

.

9 日本国特許庁(JP)

⑩特許出題公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-89541

®int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❷公開 平成4年(1992)3月23日

G 01 L 9/04

101

9009-2F

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

❷発明の名称 半導体圧力センサ

②特 顕 平2-205669

❷出 頤 平2(1990)8月2日

発明者 加藤

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

邳出 願 人 富士電機株式会社 神奈

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

個代 理 人 弁理士 山口 麗

平3-517322同等

### 明 和 1

1、発明の名称 辛業体圧力センサ

2.特許牌次の範囲

1)半導体基体のダイヤフラム部に形成された変ゲージを有する圧力トランスジューサとその圧力トランスジューサととよりなるものにおいて、信号処理回路が半導体基件に整視された回盟素子と半導体基体を収容する容器外に配置された個型可能の延續とよりなることを特徴とする半導体圧力センサ。

21年本体基体のダイヤフラム部に形成された登ゲージを有する圧力トランスジューサとその圧力トランスジューサとの比力信号の処理回路とよりなるものにおいて、信号処理回路が半導体基件に収集された個型可能の抵抗とよりなることを特徴とする半導体圧力センサ。

3) 半導体基体がシリコンよりなる関求項目あるいは 2 記載の半導体圧力センラ。

3. 発明の詳細な説明

#### (密集上の利用分野)

本発明は、半単体基体に形成されたダイヤフラム部に異なる単電型の弦ゲージを有し、そのダイヤフラム部に加えられる圧力を電気信号に変換する圧力トランスジューサと、その圧力トランスジューサの出力信号の準備。 回覧を行うための後期 増配 および 延抜を合む 回路とよりなる半導体 日カセンサに関する。

### (従来の技術)

近年、半導体圧力センサに対する小形軽量化。 低コスト化の要求が自動車向けなどの分野で急速 に高まってきており、その要求に答えるため、登 ゲージを含んだすべての回路を子を、筒一半導体 チップに半導体でのセスにより形成したワンチッ で型圧力センサの顕発が進められている。

このようなワンチップ型圧力センサにおいては、 国籍属子が第2回仰に示すようなレイナウトで構 味されている。シリコンチップ1は第2回回の新 国回に示すように、ダイヤフラム部11を有し、こ のダイヤフラム部に拡散によって重ゲージ21.22、

特開平4~89541 (2)

### (発明が解決しようとする提配]

このようなワンチップ型の半年体圧力センサは、 回路ポテがーチップ上に気積されるために構造が 簡単であり、小形、騒動。 促コストを実現するこ

液体であり、気泡が内に残らない状態で封止され

る。外部からの圧力はシールダイヤフラムと導質

を挺由してチップのダイヤフラムに加えられる。

とができるが、一方では次のような問題点を有す る。

W)トリミング後にケース内に満たされる異質55お よびシールデイヤフラム57により、トリミング により何難した特性、特に零奪位および圧力感 皮が影響を受け、センサ出力の特皮を悪化させる。

制制数十~数百mの無限低低をトリミングするためには、選常事前にチャブ上のパターンを自動
アライメントにより合わせるが、容易52とスペーラ51の間、スペーラ51とチップ 1 の間などの
位置ずれが大きいと、アライメント不能になったり、手動で手間をかけてアライメントを被言
を得なくなる。それらを避けるためには常
性の組立技術が必要とされ、コストアップの一
要因となる。

本発明の目的は、上版の問題を解決し、所望の 出力特性が得られるように調整した抵抗の値がそ の後の製造工程で変動することのない半導件圧力 センサを提供することにある。

### (群題を解決するための手段)

### 【作用】

半導件圧力トランスジューサの信号処理回路の一部をなす無抗を開発可能にし、しかもトランスジューサの年準体基体と関値にすることにより、この抵抗によってセンラ出力の考定位あるいはだ力が変の無符的な関数が可能になるため、平準に力が変化を容易に収容する際などの常能位あるいはに力が変化を確保することができ、その数の出

特開平4-89541 (3)

力特性の変化がなくなる。
(実施例)

第1回W。 Bi は本発明の一実施例の半導体圧力 モンサを示し、無3箇と共通の商分には同一の存 号が付されている。第1回回に示すようにダイヤ フラム部11を有するシリコンチップ【がスペーサ 51の上に固定され、モのスペーサ51が容異52に固 者されていることは無る関と同じである。第4醛 M. Mはチップ1モ示し、第2回と共通の部分に は関一の符号が付されている。無く図りに示すよ うにチップ1のダイヤフラム郎11には亞ゲージ21 ~24、肉厚部には演算増倡器OP1、OF2 、雜层征抗 31~36および拡散低抗41~43が形成され、また Vec. G.4および V... の各ポンティングパッド のほか、考覧位外部開製用のパッドもおよび圧力 趙寅県都興整用のボンディングパッド 62が設けら れている。これらの型両条子は第5回のような目 **塾を持成する。国中の各国路夏素は、第4国の房** 一行号を付した各部分に対応する。澄ゲージ21~ 24により構成されるブリッジ国際のゲージ21とゲ

- ジ28との接続点人に、 V ze 編子から電視電圧が 印制され、ゲージ22とゲージ24との投資点 B が C = a 猫子によって接地単位に投稿される。ブリッ ジ回島のゲージ21とゲージ22との提供点Cはブリ ッジ出力権子の片側であり、第1回の上重56の関 ロディップ回答に扱けられたシールダイヤフラム 57と容器内に摘たされる整質55を介して加えられ を圧力と、チップトとスペーサ51に囲まれた空間 58の内部の冥空との間の正力度、すなわち絶対圧 によって電位が低下する。この電位は、資源増展 異OP1 によるボルテージフォロワ回角でインピー ダンス変装される。演算維輯器OP1 と抵抗35.72. 43,36 で送動堆幅繋が構成される。ブリッジ団段 のゲージ24とゲージ23の接換点Dはブリッジ出力 扇子のもう片側であり、覆ゲージ面からの加圧に より電位が上昇する。この電位とOP1 の出力電位 の芸動電圧をこの多動増幅器で増幅してVャャヒ・等 子に出力する。この回路の増稲皮、すなわちセン サの圧力感度は低気35をトリモングすることによ り調整される。猛然72は、チップ外に殺けられた

可査任技で、ポンディングパッド61.62 を介して 電気的に接続され、この抵抗値を変えることによ り、低抗35と阿依圧力態度の調整が可能である。 鉄散推抗43は、例えば3000~4000psm/七の正の大 まな温度佐存性を有しており、抵抗36を並列接続 して思いることにより差断増稿器の増稿度に正の 温皮依存性を持たせ、亜ゲージブリッジの加圧に よって生じる信号電圧の負の重度依存性を補償し ている。推放31~34、抵放41,62 およびナップ外 に設けられた可差抵抗11は着電位の横頂。 調整に 関する抵抗である。センサ出力箱子Voorの写電 位は、在戊31もしくは32をトリミングすることに より正あるいは女の方向に解整される。抵抗心、 42は提放43と何じく正の温度抜存気を有しており、 それぞれ皮列に接続れている抵抗33、34 いずれか をもりミングすることにより、センサ出力端子 Va.の写電位の温度特性を正、負頭方向に調整 することが可能である。抵抗71はポンティングパ ッドVcc.Catも介してチップ内に歴統されてお り、さらにOP? の反転入力電子がポンディングパ

ッド 61を介して外部抵抗71の可要である分割点に 接続される。この分割点を助かすことにより、医 抗31.32 と同様、センサ出力延圧の零電位を調整 することが可能である。

多6因に示すポンディングパッドVaa Gi. V...、および61.62 は、それぞれ事)図目に示す 外部引出し月晌子81.82.83.84.85に連載53で接続 される。 着子81,82 の間に可変抵抗71が接続され、 抵抗の分割点が獅子84に換続される」また罐子84。 85の間に可変抵抗72が接続される。可変抵抗71. 12は舞る図に同じなりを付された抵抗に対応する。 音器52内にチップーを収容した状態でこのような 接続を行ったのち、御殿抵抗のレーザトリミング が行われる。トリミングは、圧力伝達媒質55を容 書内に入れ、上笠56、シールダイヤフラム57によ う気泡が残らないように封止する。この解費SS。 シールダイヤフラム57の影響によりセンサ出力の 毎電位。圧力感度が変化しても、電源電圧を印放 し、あるいはさらに外部からの圧力をシールダイ ヤフラム57、英賀55を経由してチップ】のダイヤ

特別平4-89541 (4)

フラム部11に加えた状態で可収抵抗71.72 を動かし、抵抗値を変えることにより再調整することが できる。このような調整方法は、第5回の国路に 機定されず、事実位と圧力感度の顕整の機能を有 する一般の半導体圧力センサの開整機質回路に透 用することが可能である。

据 6 図は他の実施術の新画図を示し、第 1 図と 共電の部分に何一の符号が付されている。この実 施例では、レーザトリミング後にシリコーンゲル 59でチップ 1 を被覆し、チップを保護する。複定 正力は上質58の関ロ部60とシリコーンゲル59を延 由してダイヤフラム部11に加えるれる。

無7回に示す表施例では、可要抵抗71.72 を容 各内部に収容したもので、シリコーンゲル59の往 入後、これらの抵抗71.72 の質疑を行う

第8 暦はさらに別の実施例の断面圏で、やはり 第1 間と共通の部分には同一の符号が付されてい る。この場合は、チップ1は中央に大の明いたスペーサ51を介して導圧管97の取付けられた容器ステム98の中央に固定される。従って、試測定圧力 は、単任 97、ステム98。スペーサ51の穴を胚由してチップ1のダイヤフラム部11の直面に加わる。チップ1は第4回に示したものと同じで、ボンディングパッド Vee. Gai. Veer 61.62 は、リードピン91,92,93,94,95に毒被53で装装され、きらにパッド61はリードピン96に強強により対止をもよりお上部は、キャップ99の治法によりが正される。キャップ99の治法によりの場合に対したアウムの対した。カードピン91.92 に、リードピン91.92 に、リードピン91.92 に、リードピン91.92 に、リードピン91.92 に、リードピン95.96 間に接接される。このような正力やいことができるができるができる。キャップ99の対応できるができる。キャップ99の対応できるができるに対応できることができる。キャップ99の対応できるができる。カードリカードピングのような正規を対応できる。キャップ99の対応できる。カードリカーでは対応できたができるができることができるとができるができる。カードリカーでは対応できる。カールの組立て経行することができる。オールの組立て経行することができるができる。カールの組立て経行するに、学覧は関係の可能を発行が表現である。

### (毎年の効果)

### 4.西面の簡単な説明

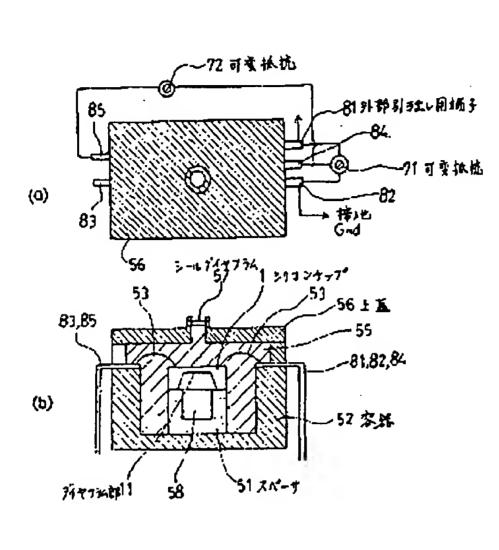
第1回は本発明の一実施例の半導体圧力センサを示し、そのうち何は平面回。 20は名名の質問題、第2世は世来の半導体圧力センサのチップを示し、そのうちのは平面回。 30は版画図、第3回は従来の半事体圧力センテの新面図、第4回は第1回の

行り、所定の無度のセンサ出力が得られる。

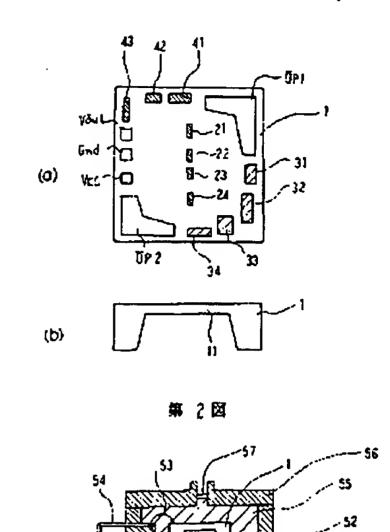
1:シリコンテップ、11:ダイヤフラム部、21,22,23,24: 歴ゲージ、31,32,33,34,34,36: 伊戦抵抗、41,42,43: 拡散抵抗、51: スペーサ、 52: 容器、56: 上並、57: シールダイヤフラム、 60: 上並関口部、61,62: ボンディングペッド、 71,72: 可変低抗、61,82,83,84,85: 外部引出し 用機子、91,92,93,94,95,96: リードピン、97: 洋圧管、98: ステム。

有成人并成士 山 口 浪

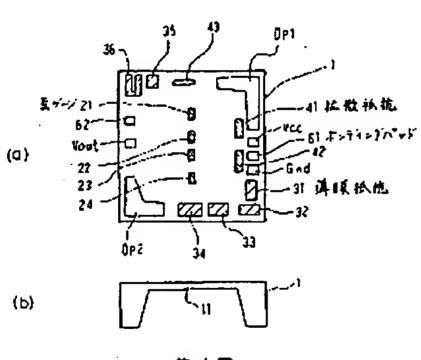
## 特閒平4-89541 (5)



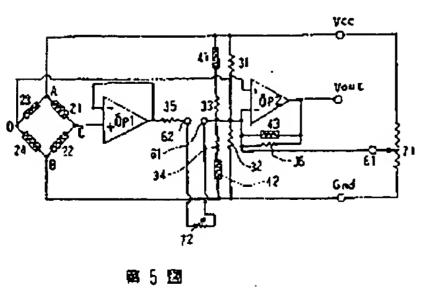
第1四



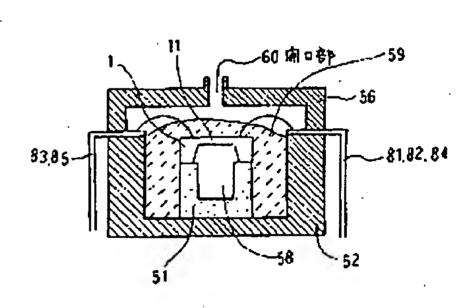
₩ 3 図



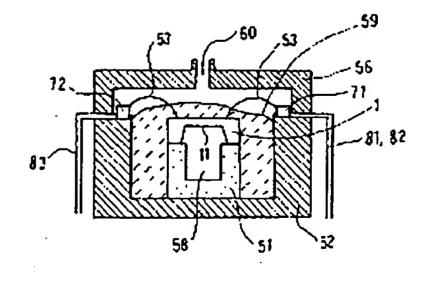
第 4 図



-283-



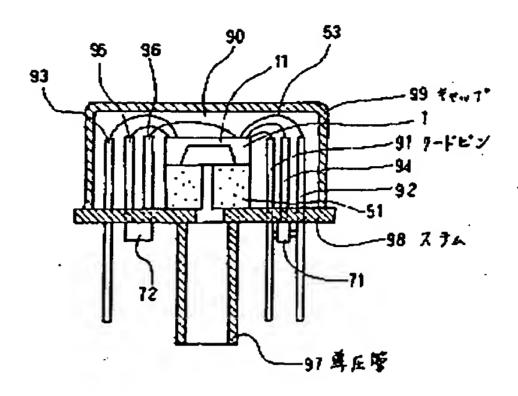
第6図



第7図

18/2

特別平4-89541 (6)



**48** B **2**3